



现在位置: 首页 > 新闻动态 > 业内信息

中芯国际将45纳米工艺技术延伸至40纳米以及55纳米

2009-11-05 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”)近日宣布其45纳米的互补型金属氧化物半导体(CMOS)技术将延伸至40纳米以及55纳米。这些新工艺技术进一步丰富了中芯国际现有的技术能力,更好地满足全球客户的需求,包括快速增长的中国市场在内。其应用产品包括多媒体产品、图形芯片、芯片组以及手机设备(如3G/4G手机)。

“中芯国际上海的12英寸厂已提前达标完成了45纳米的技术工艺。我们也同样期盼着这些附加的延伸技术能取得佳绩。”张汝京博——中芯国际总裁兼首席执行官表示,“这些新技术为我们现有的客户和新客户提供了一系列的定制解决方案,以满足他们对不同产品的设计需求。”

(来源: 半导体国际 2009年10月14日)

>> 评论

通知公告 MORE

- 中国科学院微电子研究所管理人员招聘启事
- 关于召开第六届研究生会换届选举的通知
- 关于举办中层干部执行力系列培训的通知
- 中国科学院微电子所冬季拔河跳绳比赛通知

新闻动态

- > 图片新闻
- > 头条新闻
- > 综合新闻
- > 学术活动
- > 科研动态
- > 通知公告
- > 业内信息



中国科学院微电子研究所 版权所有单位名称:中国科学院微电子研究所 单位邮编: 100029
单位地址: 北京市朝阳区北土城西路3号 电子邮件: webadmin@ime.ac.cn